

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۳۹۰۱۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۱

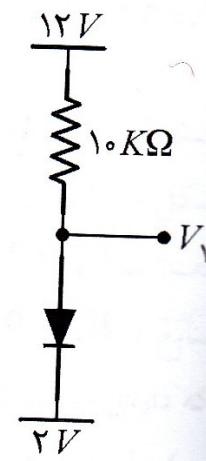
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- مطلوبست محاسبه مقدار  $I_s$  برای یک دیود پیوندی که در ولتاژ مستقیم ۰/۷ ولت جریان ۱ میلی آمپر و در ولتاژ ۰/۸ ولت جریان ۱۰ میلی آمپر از آن عبور می کند.

۲- برای یک دیود در دمای ۱۲۵ درجه سانتیگراد، جریان اشباع معکوس برابر ۱۰/۰ میکرو آمپر است. در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد مقاومت دینامیکی را در ولتاژ مستقیم ۰/۸ ولت بدست آورید.

۳- کاربرد مدار کلمپ را توضیح دهید و منظور از مدار کلمپ در سطح صفر چیست؟

۴- ولتاژ  $V_1$  را بدست آورید. (دیود ایده آل است).



سری سوال: ۱ یک

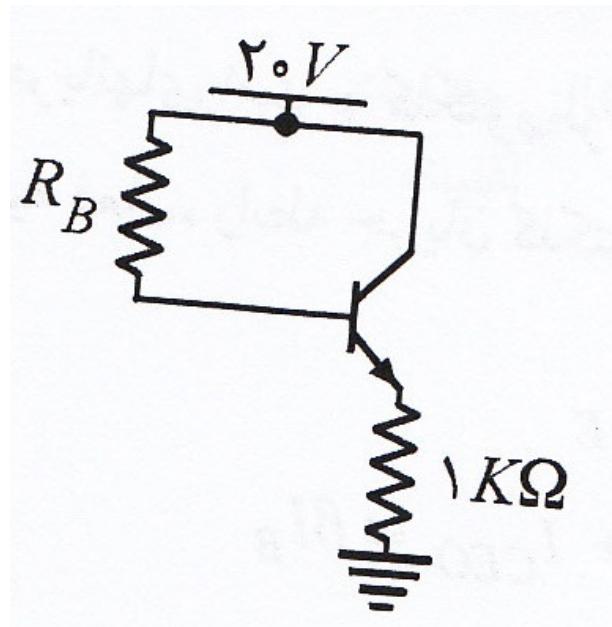
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

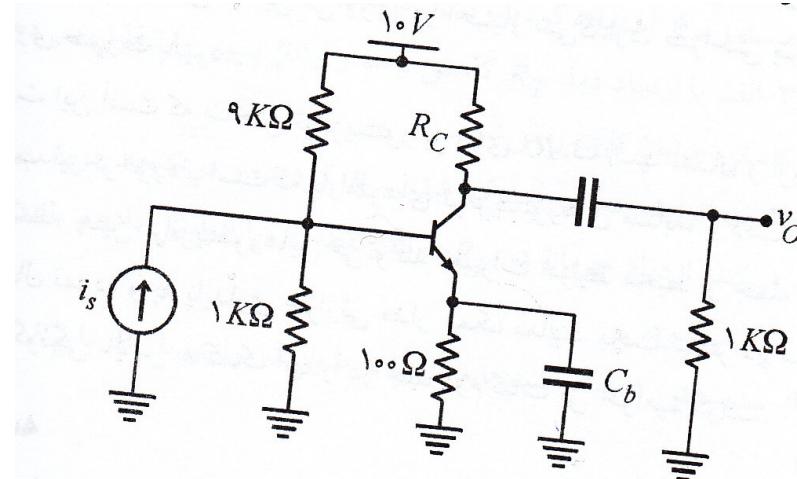
عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی برق - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۱ - ۱۳۹۰۱۹، گرایش بیومکانیک - گرایش برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۱ - ۱۳۹۰۱۹

- ۲۰۰ نمره - برای ترانزیستور مدارشکل رسم شده، فرض کنید  $\beta = 100$  ،  $V_{BE}(ON) = 0.7V$  باشد. مقدار  $R_B$  را بگوئه ای تعیین کنید که  $V_{CE} = 10V$  شود.



- ۲۰۰ نمره - در مدارشکل زیر، با فرض  $\beta = 100$  ،  $V_{CE}(sat) = 0.2V$  مقدار  $R_C$  را طوری تعیین کنید که دامنه نوسان متقارن ولتاژ  $V_o$  حداقل شود.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۳۹۰۱۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۱

۲۰۰ - برای مدار تقویت کننده شکل زیر،  $R_E = 1^{K\Omega}$ ,  $R_B = R_1 \parallel R_2 = 500^{K\Omega}$ ,  $R_s = 100^{\Omega}$  داده شده اند. کمیت

.(  $h_{oe}$  با صرفنظر از  $h_{re}$  و  $h_{fe} = 50$ ,  $h_{ie} = 1.1^{K\Omega}$  را محاسبه نمایید. )  $A_V$

